

2SB1426

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ
 Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor
 低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
 ストロボフラッシュ用/Strobo Flash

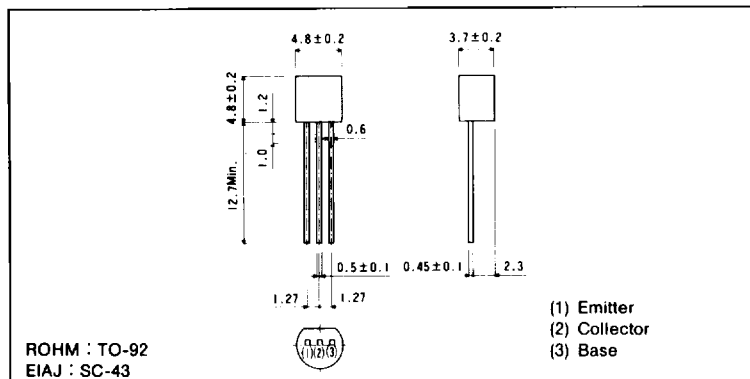
● 特長

- 1) $V_{CE(sat)}$ が低い。
 $V_{CE(sat)} = -0.5V (Max.)$
 $(I_C/I_B = -2A/-0.1A)$
- 2) 直流電流増幅率 h_{FE} の電流特性が優れている。

● Features

- 1) Low $V_{CE(sat)}$.
 $V_{CE(sat)} = -0.5V (Max.)$
 $(I_C/I_B = -2A/-0.1A)$
- 2) Excellent current characteristics of DC current amplification factor h_{FE} .

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-20	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-20	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-6	V
コレクタ電流	I_C	-3	A(DC)
		-5	A(Pulse)*
コレクタ損失	P_C	750	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

* Single pulse $P_W = 10ms$ ● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	-20	—	—	V	$I_C = -50 \mu A$
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	-20	—	—	V	$I_C = -1mA$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	-6	—	—	V	$I_E = -50 \mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	-0.1	μA	$V_{CB} = -20V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	-0.1	μA	$V_{EB} = -5V$
直流電流増幅率	h_{FE}	82	—	390	—	$V_{CE}/I_C = -2V/-0.1A$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ *	—	—	-0.5	V	$I_C/I_B = -2A/-0.1A$
利得帯域幅積	f_T	—	240	—	MHz	$V_{CE} = -2V, I_E = 0.5A, f = 100MHz$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	35	—	pF	$V_{CB} = -10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

* パルス測定

 h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h_{FE}	82~180	120~270	180~390

● 標準品・標準品一覧表

(○)：標準品

Type	h _{FE}	包装名	バルク	テーピング		
		記号		T91	T92	T93
		基本発注単位(個)	1000	1500	1500	1500
2SB1426	PQR		(○)	(○)	(○)	(○)

● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves

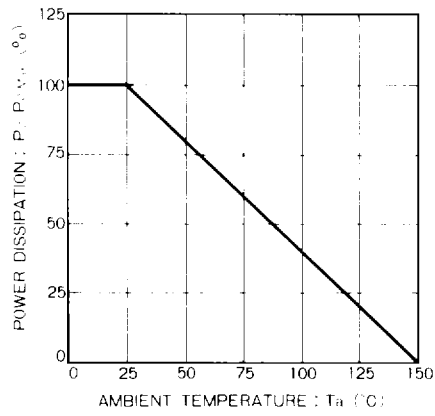


Fig.1 電力軽減曲線

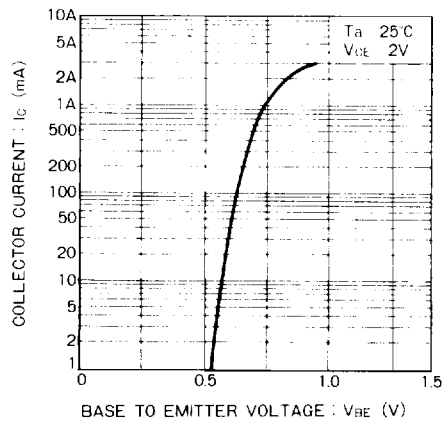


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

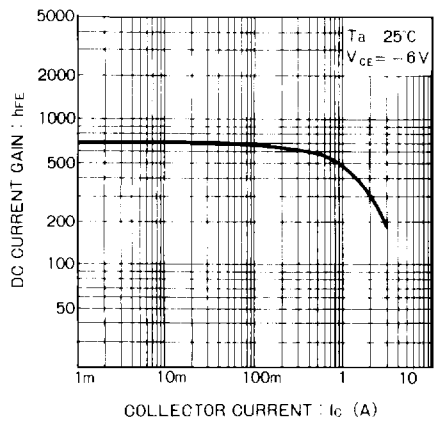


Fig.3 直流電流増幅率-コレクタ電流特性

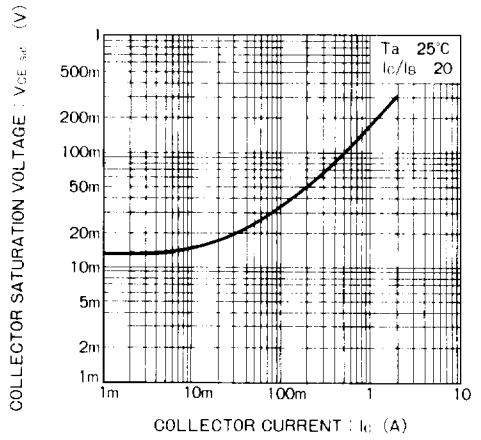


Fig.4 コレクタ・エミッタ飽和電圧-コレクタ電流特性